

OFERTA DE EMPLEO

JUAN DE LA CIERVA – FORMACIÓN

DATOS GENERALES

Puesto: Juan de la Cierva - Formación en el Grupo de Caracterización de Materiales y Dispositivos Electrónicos (GIR GCME)

Referencia: JCFUva-001

Entidad: Universidad de Valladolid

Tipo de contrato: obra o servicio, incorporación sujeta a la concesión de la ayuda

Dedicación: jornada completa

Localidad: Valladolid

Nº de plazas: 1

PERFIL PROFESIONAL

Nivel académico: Doctor para completar su formación investigadora postdoctoral dentro del programa de Ayudas Juan de la Cierva-formación 2016 del Ministerio de Economía y Competitividad.

Titulación académica: Doctor en Ciencias Físicas o Doctor Ingeniero

Competencias adicionales (se valorará):

Publicaciones

Comunicaciones en Congresos

Estancias en el extranjero

Idiomas: Inglés

Experiencia en el manejo de instrumentación electrónica

Programación: MATLAB, LABVIEW

Ofimática

REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA

<http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=63b7c44759da7510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=11f35656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD>

Formación pre-doctoral realizada en otro centro de I+D distinto a la Universidad de Valladolid.

Grado de Doctor: Fecha de obtención de grado de doctor: 01/01/2015 - 31/12/2016.

No presentar solicitud de participación a las ayudas Ramón y Cajal o a las ayudas Juan de la Cierva-incorporación en la presente convocatoria.

No haber sido beneficiario de una ayuda Juan de la Cierva o Formación posdoctoral de las convocatorias anteriores.

FUNCIONES

Integrado en el GIR GCME, y en el marco de un trabajo en equipo, tendrá la oportunidad de realizar tareas de investigación en un laboratorio experimental orientadas a la optimización de tecnologías innovadoras en los siguientes campos:

- Memorias RRAM, alternativas a las actuales SRAM, DRAM y Flash, basadas en nuevos materiales que presentan efectos de conmutación resistiva, fabricadas en laboratorios punteros europeos.
- Materiales ferroeléctricos, para su aplicación en el ámbito de las memorias multiferroicas.
- Nuevas generaciones de circuitos integrados basadas en la utilización de aislantes de alta permitividad y espesores nanométricos.
- Nuevos conceptos de dispositivos fotovoltaicos: Células solares de silicio con banda intermedia, y células multiunión de semiconductores III-V.

El objeto final de esta investigación es la identificación y caracterización de los mecanismos físicos subyacentes al funcionamiento de los dispositivos, así como la detección, y posterior minimización y control de imperfecciones, defectos e impurezas en los dispositivos a fin de conseguir estructuras de alta calidad para su posterior incorporación a las líneas de fabricación masiva.

Las investigaciones se llevarán a cabo en colaboración con prestigiosos grupos de investigación nacionales e internacionales. Los resultados de la investigación se publicarán en revistas indexadas en el Journal of Citation Report y se presentarán en Congresos Internacionales especializados.

Enviar las candidaturas a tecnico.parque.cientifico@uva.es indicando JCFUVa-001
Plazo de presentación de candidaturas: hasta las 19:00 horas del 24 de enero de 2017